

05:09:12

©1993

# ГИГАНТСКИЙ СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ В КИРАЛЬНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СРЕДАХ, НЕ ОБЛАДАЮЩИХ СТАТИЧЕСКИМИ МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

*Ю.Н.Казанцев, Г.А.Крафтмакер*

В последнее время увеличился интерес к электродинамике так называемых киральных сред, обладающих пространственной дисперсией в отсутствие центральной симметрии и проявляющих свойства оптической активности. Киральными проявляют себя сплошные полимеры, биологические объекты, например, ДНК, белки-коллагены, в молекулах которых расположение атомов имеет вид спиральных цепочек.

Существенно новым является создание искусственных композитов со спиральными включениями, пространственно подобными упомянутым молекулам и переход в СВЧ диапазон [1–3]. При этом, как правило, размеры включений  $a \ll \lambda$  ( $\lambda$  — длина волн), но достаточные для влияния пространственной дисперсии.

Однако экспериментальные методы исследований киральных композиционных сред в СВЧ остались оптическими. Они посвящены обнаружению и измерению вращения  $\theta$  плоскости поляризации линейно-поляризованной волны, прошедшей через слой киральной среды аналогично [1]. На основании таких данных о  $\theta$  и эллиптичности  $\mathcal{E}$  делаются оценки магнитной проницаемости киральной среды  $\mu'$  и  $\mu''$ , что в оптике не имело смысла, поскольку учет отличия  $\mu$  от 1 является превышением точности для большинства явлений при частотах, гораздо более низких, чем оптические [4].

Основой феноменологической теории киральных сред являются материальные уравнения, характерные для сред с пространственной дисперсией, имеющие вид [5]

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon \mathbf{E} - jk\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \mathbf{H} \\ \mathbf{B} &= \mu \mathbf{H} + jk\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \mathbf{E} \end{aligned} \quad (1)$$

где  $\varepsilon$ ,  $\mu$  — диэлектрическая и магнитная проницаемости среды,  $K$  — коэффициент киральности.

Если в СВЧ киральные среды, не проявляющие статических магнитных свойств, обладают магнитной проницаемостью, то возникает задача провести прямые измерения  $\mu$ , используя средства и специфику СВЧ.

Взаимодействие с СВЧ связано с возникновением спиральных колышевых токов, которые наводятся как переменным электрическим полем, так и магнитным. Поэтому тепловые потери в спиральных витках могут проявляться в некоторых ситуациях как магнитные потери, а среда с киральными включениями как магнитодиэлектрик.

Наиболее чувствительным методом разделения эффектов  $\epsilon$  и  $\mu$  на СВЧ является резонаторный метод с применением теории возмущений.

В [6] получены соотношения, связывающие параметры резонатора с параметрами киральных и биизотропных сред:

$$\Delta f = -\frac{f}{4W_0} \int_{\Delta V} \left[ (\epsilon - \epsilon_0) \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}_0^* + (\mu - \mu_0) \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}_0^* + 2jk\sqrt{\mu_0\epsilon_0} \operatorname{Im}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{H}_0^*) \right] dV, \quad (2)$$

где  $\Delta V$  — объем образца,  $V$  — объем резонатора,  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{H}$  — комплексные амплитуды поля внутри образца,  $\mathbf{E}_0$ ,  $\mathbf{H}_0$  — комплексные амплитуды поля в невозмущенном резонаторе,

$$W_0 = \frac{1}{4} \int_v (\epsilon_0 \mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{E}_0^* + \mu_0 \mathbf{H}_0 \mathbf{H}_0^*) dV$$

— энергия поля в невозмущенном резонаторе.

Из (2) видно, что в пучности электрического (магнитного) поля сдвиг резонансной частоты зависит только от  $\epsilon$  ( $\mu$ ), если поле в образце не отличается от поля в резонаторе. Это обычное условие теории возмущений, позволяющее легко разделить эффекты  $\epsilon$  и  $\mu$ .

Поэтому задача прямых измерений  $\epsilon^*$  и  $\mu^*$  киральных сред сводится к созданию образцов, удовлетворяющих требованиям применимости резонаторного метода на основе теории возмущений.

В данной работе были созданы и измерены образцы, представляющие собой полые цилиндры с боковыми стенками из многозаходных ориентированных изолированных спиральных витков (в 1.5 оборота), помещенных между двумя диэлектрическими пленками (рис. 1). Диаметр цилиндров 2.3 мм, длина  $L = 80 \div 20$  мм, диаметр провода 0.015 мм, длина спирали  $l = a / \sin \alpha$ ; шаг спирали  $\Delta = a \operatorname{ctg} \alpha$ , где  $a = 8$  мм,  $\alpha$  — угол накрутки спирали. Концентрация — 40 витков на длине 1 см, что соответствует 0.2% объемных металла.

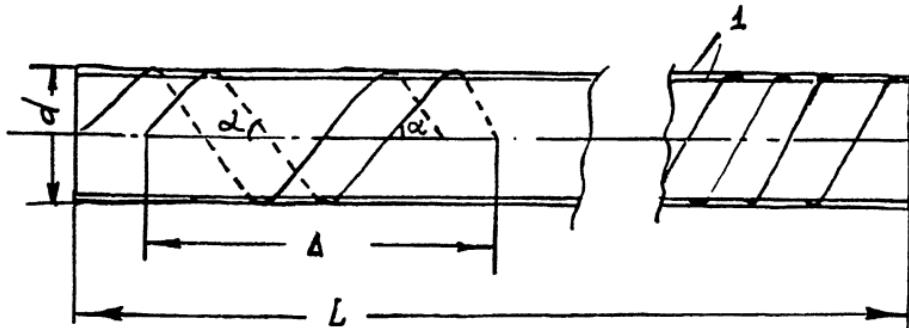


Рис. 1. Образец с многозаходными ориентированными спиральными витками. 1 — диэлектрические пленки.

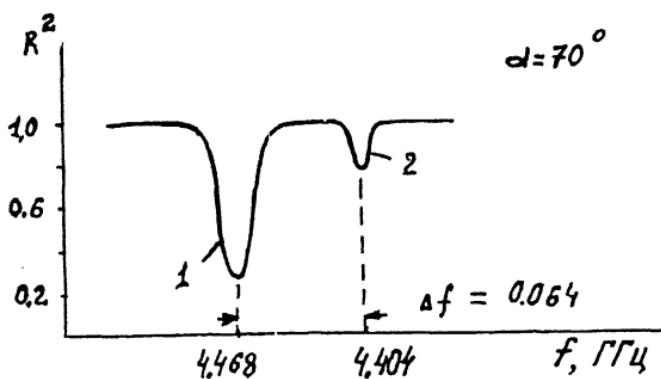


Рис. 2. Измеряемые параметры: резонансная частота и коэффициент отражения от резонатора. 1 — невозмущенный резонатор, 2 — резонатор с образцом.

Исследовались разные образцы одного и того же диаметра, отличающиеся величиной  $\alpha$ , т.е. шагом и длиной спирального витка.

Измерения проводились в полуволновых прямоугольных резонаторах с применением панорамных измерителей КСВ в диапазоне 3–5 ГГц аналогично [7,8] при параллельной и перпендикулярной ориентации электрического и магнитного СВЧ полей относительно оси цилиндров (ось Z).

На рис. 2 представлены типичные зависимости измеряемых параметров, дающие представление о величине эффек-

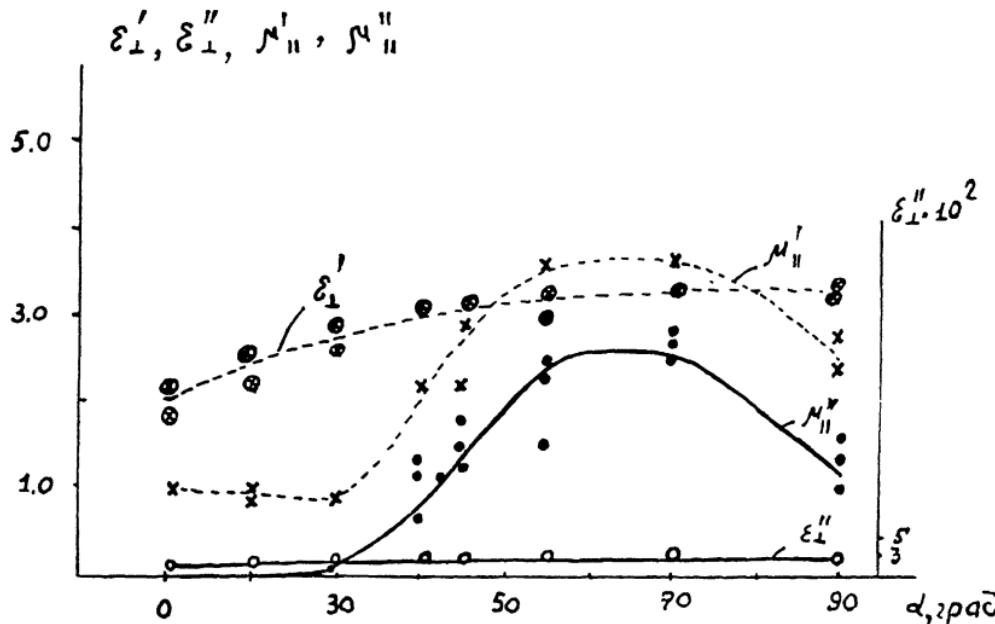


Рис. 3. Зависимость действительной и мнимой частей  $\epsilon'_\perp$ ,  $\epsilon''_\perp$  диэлектрической (магнитной  $\mu'_\parallel$ ,  $\mu''_\parallel$ ) проницаемостей при  $E \perp Z$  ( $H \parallel Z$ ) от угла накрутки спирали  $\alpha$ .

та. Все последующие зависимости  $\epsilon$  и  $\mu$  являются результатом вычислений и обработки кривых типа рис. 2. Так, на рис. 3 приведены зависимости действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости  $E'_\perp$ ,  $E''_\perp$  ( $E \perp$  оси образцов  $Z$ ) и соответственно магнитной проницаемости  $\mu'_\parallel$ ,  $\mu''_\parallel$  ( $H \parallel$  оси образцов  $Z$ ) от  $\alpha$  на частоте 4.4 ГГц. Из рис. 3 видно:

1. Имеется зависимость  $\mu'_\parallel$  и  $\mu''_\parallel$  от  $\alpha$ . При малых  $\alpha$  (от нуля до 20 градусов), соответствующих сильно вытянутым виткам, практически не наблюдается отличие  $\mu'_\parallel$  от 1,  $\mu''_\parallel$  от 0.

2. При увеличении  $\alpha$  наблюдается увеличение  $\mu'_\parallel$  и  $\mu''_\parallel$  с максимальными значениями в интервале  $\alpha = 50-70^\circ$ ;  $\mu'_\parallel - 1 \gg 0$  (парамагнитный эффект) и  $\mu''_\parallel \gg 0$  (магнитные потери), при этом  $\mu'_\parallel \simeq \mu''_\parallel$ . В [9] реализован искусственный диамагнетик на основе замкнутых кольцевых токов, в котором обнаружены на СВЧ магнитные потери. Однако отличие  $\mu'$  от 1 не наблюдалось.

3. Наблюдаются слабые зависимости  $\epsilon'_\perp$  и  $\epsilon''_\perp$  от  $\alpha$ . С ростом  $\alpha$  (уменьшением шага спирали) незначительно увеличивается  $\epsilon'_\perp$  и  $\epsilon''_\perp$ .

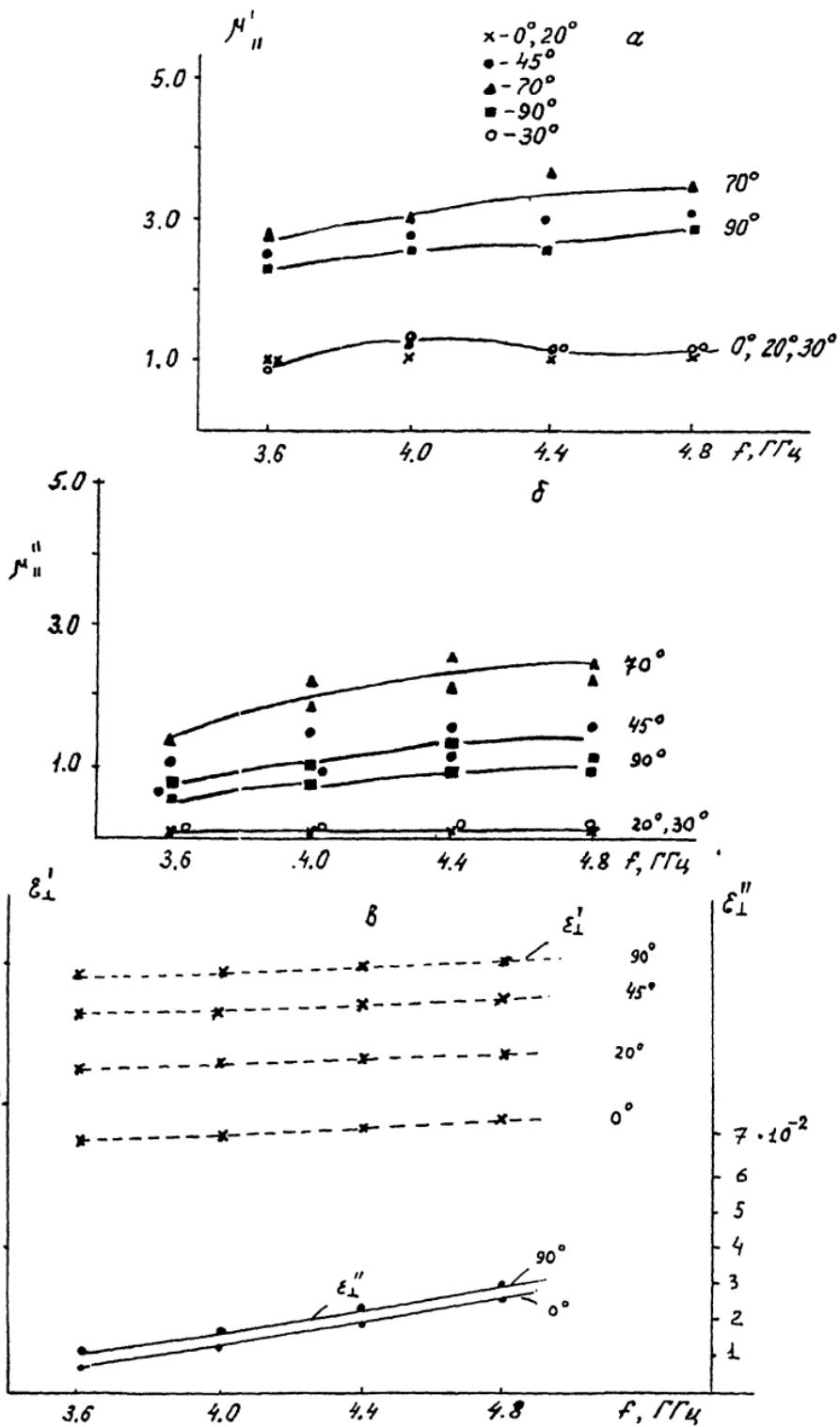


Рис. 4. Частотные зависимости диэлектрической и магнитной проницаемостей для разных образцов, отличающихся углом накрутки  $\alpha$ : а, б —  $\mu_{\parallel}'$  и  $\mu_{\parallel}''$ , в —  $\epsilon_{\perp}'$  и  $\epsilon_{\perp}''$ .

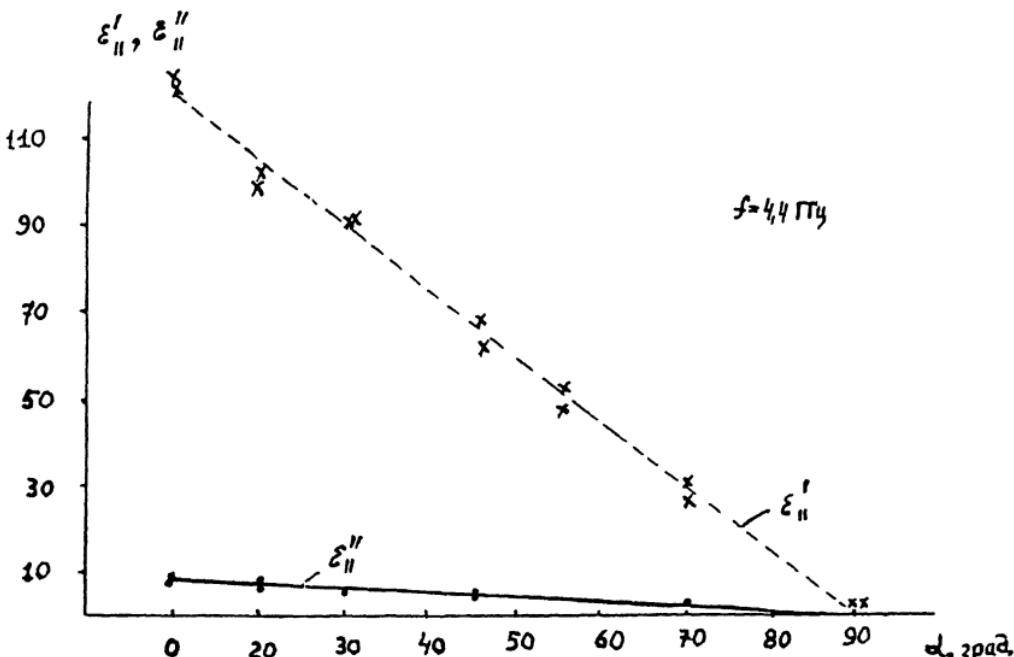


Рис. 5. Зависимость действительной  $\epsilon'_{\parallel}$  и мнимой  $\epsilon''_{\parallel}$  частей диэлектрической проницаемости от угла накрутки спирали  $\alpha$  при  $E \parallel Z$ .

4. Имеется область значений  $\alpha \approx (50 - 70^\circ)$  с высокими значениями магнитной проницаемости  $\mu'_{\parallel}$ , близкими к диэлектрической  $\epsilon'_{\perp}$ ,  $\mu'_{\parallel} \approx \epsilon'_{\perp}$ . Отметим, что в типичных композитах на основе шариков железа  $\epsilon'$  превышает  $\mu'$  в 15–20 раз, и  $|\mu|$  достигает аналогичных значений при концентрации металла 60% объемных.

На рис. 4 приведены частотные зависимости  $\mu'_{\parallel}$ ,  $\mu''_{\parallel}$  (а, б) и  $\epsilon'_{\perp}$  и  $\epsilon''_{\perp}$  (в) для образцов с разными  $\alpha$ , свидетельствующими о распространении результатов рис. 4 на другие частоты и о слабой зависимости от частоты.

На рис. 5 приведены зависимости  $\epsilon'_{\parallel}$  и  $\epsilon''_{\parallel}$  ( $E \parallel$  оси цилиндрических образцов  $Z$ ) от  $\alpha$  на частоте 4.4 ГГц. В этой ситуации наблюдается сильная зависимость от  $\alpha$ . При изменении  $\alpha$  от 0 до  $90^\circ$  (от сильно вытянутой спирали до кольца)  $\epsilon'_{\parallel}$  падает от 120 до 1.5, а  $\epsilon''_{\parallel}$  от 7 до  $3 \cdot 10^{-2}$ . Эти результаты повторяются и на других частотах.

Сравнивая рис. 5 и 4, в, видим, что в области значений  $\alpha$ , близких к  $90^\circ$  (малый шаг спирали),  $\epsilon'_{\perp} \approx \epsilon''_{\parallel}$  — практически изотропный вариант. При  $\alpha \approx 0; 20^\circ$   $\epsilon'_{\parallel} \gg \epsilon'_{\perp}$ ,  $\epsilon''_{\parallel} \gg \epsilon''_{\perp}$  — большая диэлектрическая анизотропия. При увеличении  $\alpha$  происходит постепенный переход от анизотропного варианта к изотропному.

Таким образом, наиболее существенными результатами данной работы нам представляются следующие:

1. Исследован новый композиционный материал — киральная среда с ориентированными многозаходными спиральными витками. Такие композиты не рассматривались ранее ни теоретически, ни экспериментально.

2. Впервые в искусственных композитах, не обладающих магнитными статическими свойствами, прямыми методами обнаружена действительная часть магнитной проницаемости  $\mu'$ , ( $\mu' - 1 \gg 0$ ) — СВЧ-парамагнитный эффект.

3. Обнаружен гигантский СВЧ-электромагнетизм — гигантские магнитные потери, наведенные СВЧ-электромагнитным полем, превышающие на два порядка магнитные потери в традиционных композитах магнитного типа при аналогичной концентрации.

(При концентрации 0.2% объемных в композитах на основе шариков железа  $\mu' \approx 1$ , а  $\mu'' < 0.05$ ).

В заключение благодарим за полезные обсуждения A.M.Sihvola и С.А.Третьякова.

### Список литературы

- [1] Umari M.H., Varadan V.V., Varadan V.K. // Radio Sci. 1991. V. 26. N 5. P. 1327–1334.
- [2] Jaggard D.L., Liu J.C., Sun X. // Electron. Lett. 1991. V. 27. N 1. P. 77–79.
- [3] Viitanen A.J., Lindell J.V., Sihvola A.H., Tretyakov S.A. // J. Opt. Soc. Am. A. 1990. V. 7. P. 683–692.
- [4] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. // Электродинамика сплошных сред. М., 1957. 320 с.
- [5] Jaggard D.L., Mickelson A.R., Paras C.H. // Appl. Phys. 1979. V. 18. P. 211–216.
- [6] Tretyakov S.A., Viitanen A.J. // Helsinki University of Technology Faculty of Electrical Engineering Electromagnetics Laboratory. Report 134. 1993.
- [7] Казанцев Ю.Н., Крафтмахер Г.А. и др. // ФММ. 1991. В. 3. С. 116–121.
- [8] Казанцев Ю.Н., Костин М.В., Крафтмахер Г.А., Шевченко В.В. // Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. В. 22. С. 19–23.
- [9] Костин М.В., Казанцев Ю.Н., Крафтмахер Г.А., Шевченко В.В. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 13. С. 22–25.

Институт радиотехники  
и электроники РАН  
Фрязинская часть

Поступило в Редакцию  
10 августа 1993 г.